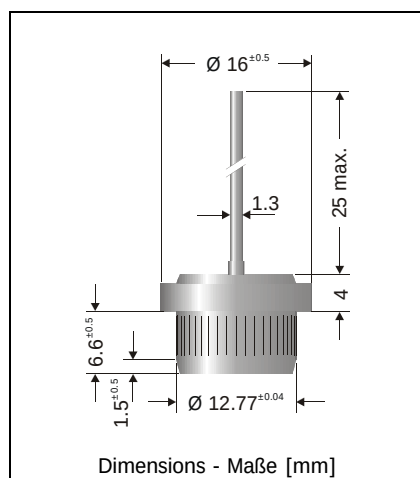


KYW25A05 ... KYW25A6, KYW25K05 ... KYW25K6
Silicon-Press-Fit-Diodes – High Temperature Diodes
Silizium-Einpress-Dioden – Hochtemperatur-Dioden

Version 2006-04-20



Nominal Current Nennstrom	25 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50 ... 600 V
Metal press-fit case with glass seal Metall-Einpressgehäuse mit Glas-Durchführung	
Weight approx. Gewicht ca.	10 g
Compound has classification UL94V-0 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton	


Maximum ratings
Grenzwerte

Type / Typ Wire to / Draht an		Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
Anode	Cathode		
KYW25A05	KYW25K05	50	60
KYW25A1	KYW25K1	100	120
KYW25A2	KYW25K2	200	240
KYW25A3	KYW25K3	300	360
KYW25A4	KYW25K4	400	480
KYW25A6	KYW25K6	600	700

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	25 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	90 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	270/300 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	375 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+175°C -50...+175°C

1 Max. case temperature $T_C = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_C = 150^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Forward Voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 25\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage Current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 100\text{ }\mu\text{A}$
Thermal Resistance Junction – Case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thc}	$< 1\text{ K/W}$

